

Сведения о научном руководителе

по диссертации Обухова Сергея Владимировича


«Ab initio теория электрон-фононных процессов в полупроводниковых кристаллах»
по специальности 01.04.10 – «физика полупроводников» на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

| | |
|--|--|
| Наименование организации, дата и номер приказа о назначении научным руководителем | Приказ по Томскому государственному университету от 01.09.2014 г., № 531/ОД |
| Фамилия, имя, отчество | Брудный Валентин Натанович |
| Гражданство | гражданин Российской Федерации |
| Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация) | доктор физико-математических наук, 01.04.10 - «физика полупроводников» / 01.04.07 - «физика конденсированного состояния» |
| Ученое звание (по какой кафедре / по какой специальности) | профессор по кафедре физики полупроводников |
| Место работы | |
| Почтовый индекс, адрес, телефон, web-сайт, электронный адрес организации | 634050, г. Томск, пр. Ленина 36, (3822) 529852, http://tsu.ru , rector@tsu.ru |
| Полное наименование организации в соответствии с уставом | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" |
| Наименование подразделения | НОЦ "Наноэлектроника" |
| Должность | Директор НОЦ "Наноэлектроника" |
| Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| 1. S.Yu. Sarkisov, A.V. Kosobutsky, V.N. Brudnyi and Yu.N. Zhuravlev. Ab initio calculations of the optical constants of GaSe and InSe layered crystals. // Physics of Solid State. – 2015. – V.57, N9. – P.1735 – 1740. | |
| 2. В.Н. Брудный, С.Ю. Саркисов, А.В. Кособуцкий. Уровень зарядовой нейтральности и электронные свойства межфазных границ в слоистом полупроводнике ϵ – GaSe // Физика и Техника Полупроводников. – 2015. – Т. 49, N.10. – С. 1351-1354. | |
| 3. A.V. Kosobutsky, S.Yu. Sarkisov, V.N. Brudnyi. Structural, elastic and electronic properties of GaSe under biaxial and uniaxial compressive stress. // J. Physics and Chemistry of Solids. – 2013. – Vol.74. – P. 1240 – 1248. | |
| 4. V.N. Brudnyi. Charge neutrality level in semiconductors: defects, interfaces, surface. // Russian Physics Journal. -2013. – Vol.56, N.7, - P. 754 – 758. | |
| 5. В.Н. Брудный, А.В. Кособуцкий. Электронная структура и уровень зарядовой нейтральности политипов SiC из квазичастичных расчетов в рамках GW- приближения. // Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. – 2012. – Т.141, Вып.6. – С. 1183-1189. | |
| 6. V.N. Brudnyi, A.V. Kosobutsky, N.G. Kolin. Effect of pressure and mechanical stress on the electronic properties of AlN and GaN. // Physics of the Solid State. – 2011. –V.53, N4. – P.679 - | |

688.

7. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, В.А. Донченко, И.В. Ивонин, А.А. Землянов. Фоточувствительные структуры на основе квантовых точек германия в кремнии. Известия вузов Физика. – 2011. – Т.54, №12/2. – С. 109 – 112.

Научный руководитель

 В.Н. Брудный

Верно

Ученый секретарь ученого совета ТГУ

11.09.2015 г.





Н.Ю. Бурова